

# 第3世代SiC MOSFETを搭載 ACEPACK DRIVE



## 小型かつ高性能な トラクション・インバータ向けモジュール



第3世代SiCテクノロジーの機能と最適化された小型設計を兼ね備え、  
HEV / EVのトラクション・インバータに最適

ACEPACK DRIVEパワー・モジュールは、ハイブリッド自動車(HEV)および電気自動車(EV)のトラクション・インバータに大電力と効率の向上を求める自動車メーカーに対応するために、特別に設計されています。

業界標準と同一の外形寸法で、すぐに使用可能なパワー・モジュールにより、ドライブ基板の設計にかかる労力を軽減し、製品の開発期間を短縮します。

直接液体冷却方式のベース・プレートにより、ACEPACK DRIVEパワー・モジュールは、最適な熱特性を提供します。また、AMB基板へのダイ取り付けに使用される焼結テクノロジーにより、より長いライフタイムを実現しています。

### 特徴と利点

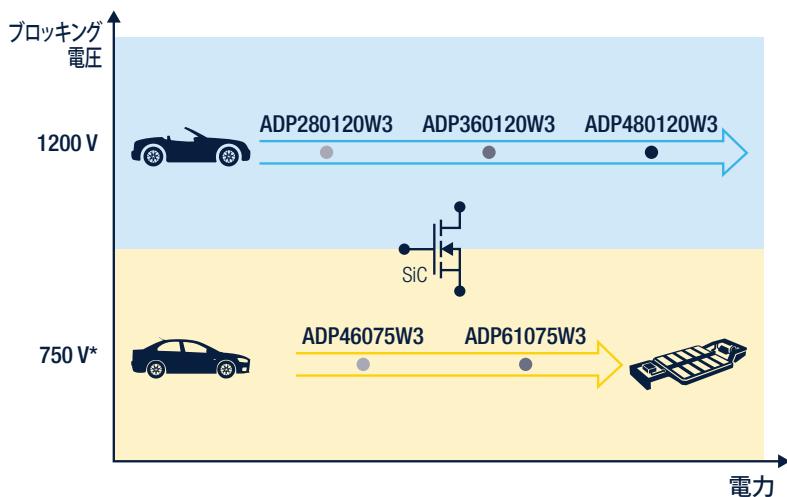
- ブレーキダウン電圧: 750V, 1200V
- 極めて高い電力密度と効率
- 最大ジャンクション温度: 175°C
- プレス・フィット端子
- AMB基板と直接液体冷却方式のベース・プレート
- 卓越したオン抵抗
- 絶縁性能: 4.2kV DC 1s
- 各基板に専用NTCを提供

### アプリケーション

メイン・インバータ(電気トラクション):

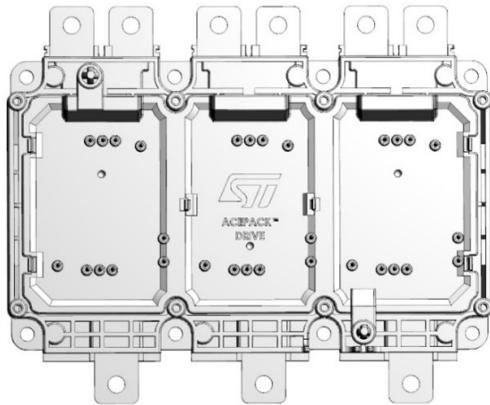
- 小型電気自動車
- UAM(アーバン・エア・モビリティ)
- 商用車、農業用車両
- トラック、バス
- 電動バイク
- スポーツ車

ACEPACK DRIVEパワー・モジュールは、最適な効率と性能を実現する第3世代のSiC MOSFETを搭載しています。さらに、このパワー・モジュールは電力密度が非常に高いため、システム・ルームの占有率を最小限に抑え、定格電圧750V\*～1200Vで180～300kW超の電力範囲をカバーすることができます。

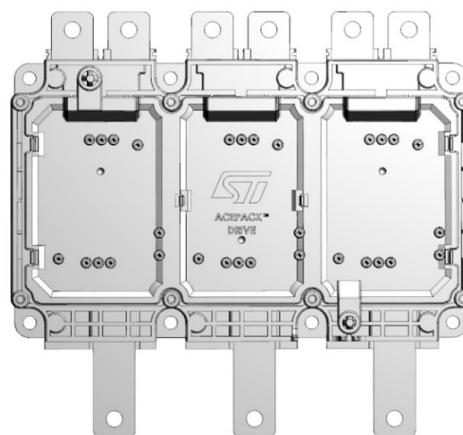


注記:\*\* 開発中

## ACバス・バー・オプションを利用可能



ショート・タブ



ロング・タブ

## 製品ポートフォリオ

品名	ブレークダウン電圧 (V)	オン抵抗@ 25°C (mΩ)	オン抵抗@ 175°C (mΩ)	目標電力 (kW)	特徴
ADP280120W3	1200	3.8	6.5	180	ショート・タブ
ADP360120W3		2.55	4.25	230	ショート・タブ
ADP480120W3		1.9	3.35	300	ショート・タブ
ADP480120W3-L	750				ロング・タブ
ADP46075W3*		1.6	2.6	175	ショート・タブ
ADP61075W3*				220	ショート・タブ
ADP61075W3-L*		1.2	1.95		ロング・タブ

注記:\*\* 開発中

© STMicroelectronics - April 2023 - Printed in Japan - All rights reserved  
STMicroelectronicsのロゴマークは、STMicroelectronics Groupの登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者に帰属します。  
STの登録商標についてはSTウェブサイトをご覧ください。[www.st.com/trademarks](http://www.st.com/trademarks)  
STマイクロエレクトロニクス株式会社 ■東京 TEL 03-5783-8200 ■大阪 TEL 06-6397-4130 ■名古屋 TEL 052-259-2725



詳細はSTウェブサイトをご覧ください：[www.st.com](http://www.st.com)